

⑯ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑯ Offenlegungsschrift  
⑯ DE 100 43 204 A 1

⑯ Int. Cl. 7:  
H 01 L 51/20  
H 01 L 51/40  
H 01 L 51/10

DE 100 43 204 A 1

⑯ Aktenzeichen: 100 43 204.2  
⑯ Anmeldetag: 1. 9. 2000  
⑯ Offenlegungstag: 4. 4. 2002

⑯ Anmelder:  
Siemens AG, 80333 München, DE

⑯ Erfinder:  
Bernds, Adolf, 91083 Baiersdorf, DE; Clemens, Wolfgang, Dr., 90617 Puschendorf, DE; Fix, Walter, Dr., 90762 Fürth, DE; Rost, Henning, Dr., 91056 Erlangen, DE

⑯ Entgegenhaltungen:

DE 198 51 703 A 1  
WO 99 10 939 A 2  
WO 97 18 944 A 2

DRURY, C.J. et al.: "Low-cost all polymer integrated circuits" in "Applied Physics Letters", 73 (1998) 1, pp. 108-110;  
LIDZEY, D.G. et al.: "Photoprocessed and micro-patterned conjugated polymer LEDs" in "Synthetic Metals", 82 (1996), pp. 141-148;  
XIANG-YANG, Zheng et al.: "Electrochemical Patterning of the Surface of Insulators with Electrically Conductive Polymers" in "J.Electrochem.Soc.", 142 (1995) 12, pp. L226f.;  
KOBEL, W. et al.: "Generation of micropatterns in Poly(3-Methyl-Thiophene) films using microlithography: a first step in the design of an all-organic thin-film transistor" in "Synthetic Metals", 92 (1998), pp. 265-271;  
ANGELAPOULUS, M. and SHAW, J.M.: "In-Situ Radiation Induced Doping" in "Mol.Cryst.Liq.Cryst.", 189 (1990), pp. 221-225;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑯ Organischer Feld-Effekt-Transistor, Verfahren zur Strukturierung eines OFETs und integrierte Schaltung

⑯ Die Erfindung betrifft einen organischen Feld-Effekt-Transistor, ein Verfahren zur Strukturierung eines OFETs und eine integrierte Schaltung mit verbesserter Strukturierung der Funktionspolymerschichten. Die Strukturierung wird durch Einrakeln des Funktionspolymers in eine Formschicht, in der zunächst durch Belichten Vertiefungen erzeugt wurden, erzielt.



7

DE 100 43 204 A 1

BEST AVAILABLE COPY